

## OIM-DC

		Entry	Basic	Advanced
OIM-DC全般	OIM-DCの概説/構成	○	○	
	EBSDパターンの指数付について		○	△
	結晶方位の算出に関する計算法について		△	○
	結晶方位の算出について(3バンド法について)	○	○	△
	CI値の意味について	○	○	
	Fit値の意味について		○	
Phase Page について	Phase データのLoad について	○	○	
	Phase Parameters の見方	○	△	○
Hough Page について	Hough 変換の原理について	○	○	△
	Hough 変換のパラメーターについて	○	○	△
Index Page について	Solutions の見方	○	○	△
	HKLs の見方		△	○
	Ranking Factor について			○
	Pseudosymmetry について			○
	バンドの追加/削除について		△	○
Interactive Page について	SEM像の取込/保存について	○	○	
	パターンの指数付け/保存(Record)について	○	○	
	Analysis 部分の見方について		△	○
Scan Page について	測定領域の設定について	○	○	
	Combo Scan について			○
	パターンの記録につて	○		○
	ChiScan について			○
Simulation Page について	Unit Cell/PF/IPF の表示について	○	○	○
キャリブレーションについて	キャリブレーションの考え方について	○	○	
	SEMのWDにキャリブレーション値を合わせる	○	○	
	Si 単結晶でキャリブレーションを行う			○
	一時的なキャリブレーションを行う			○
Setting Menu について	Preference の設定			○
Superuser の設定	Environment Setting (座標系/試料傾斜角の設定)			○
その他の機能	SEM 像の Brightness/Contrast の調整			○
	取込むSEMの解像度の設定について			○
	SEM像の傾斜補正について			○
検出器の調整	Gain, Black, Exposure と照射電流の関係	○	○	
	Binning パラメータとConvolution Mask の関係			○
Backgraound 処理について	Background処理の考え方	○	○	

## OIM-DC

		Entry	Basic	Advanced
	Standard モードによるBackground 処理		○	
	Enhanced モードによるBackground処理(1)	○	○	○
	Enhanced モードによるBackground処理(2)			○
SEM の条件設定	加速電圧の効果	○	○	△
	倍率と分解能の関係		○	△
	統計的データの意味			○
透過EBSD法に関して	透過EBSD法とは		○	○
	透過EBSD法における試料のセットについて		○	○
	試料厚さの効果について			○
	透過電子線の処理について			○
	Hough変換パラメーターのチューニング			○
マテリアルデータの作成に関して	同一結晶系/類似データの編集による作成			△
	ICDD等データベースを利用したデータの作成			△
	実際のパターンから結晶の対称性を推測			△
	実際のパターンでのマッチングによる確認			△

\* 同じ項目に○が付いていても、Entryコース、Basicコース、Advancedコースで内容が同じということではありません。